

RCA

Triac 40842

Datasheet

Silicon Triac

40842

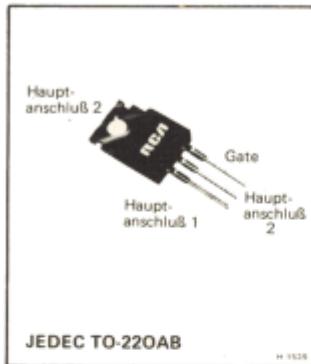
6A Triac

450V / 6A

DATASHEET

OEM –RCA

Source: RCA Databook 1975

Triacs**T2801DF****6-A-Triac**

Für Leistungssteuerungen und Leistungsschaltanwendung

T2801DF, bisher 40842

Eigenschaften

- Stoßstrom 100 A für eine Vollwelle bei 60 Hz,
85 A für eine Vollwelle bei 50 Hz
- „Shorted-Emitter“-Technik – enthält eindiffundierten Widerstand zwischen Gate und Hauptanschluß 1
- Aufbau mit zentralem Gate – ermöglicht schnelles und gleichmäßiges Ausbreiten des Gatestromes und damit schnelleres Zünden bei beträchtlich herabgesetzter lokaler Erwärmung
- Geringe Schaltverluste
- Niedriger Wärmewiderstand ■ Gehäuse zur Montage auf gedruckten Leiterplatten

Der RCA-T2801DF (früher 40842) ist ein Gate-gesteuerter Wechselstromschalter für Vollwellenbetrieb. Sein Hauptanwendungsgebiet ist die Steuerung von Wechselstromlasten, beispielsweise die Drehzahlsteuerung von Motoren, Beleuchtungsregelung (300 bis 1440 W), Temperaturregelung und Leistungsschaltsysteme.

Der Triac schaltet vom gesperrten in den eingeschalteten Zustand, wenn am Gate eine positive oder negative Trigger-

spannung liegt, und zwar unabhängig von der Polarität der Spannung an den Hauptanschlüssen. Der Durchlaßstrom beträgt max. 6 A bei $T_C = 80^\circ\text{C}$, die periodische Spitzensperrspannung liegt bei 450 V.

Das Plastikgehäuse bietet nicht allein bequeme Einbaumöglichkeiten, es zeichnet sich auch durch einen niedrigen Wärmewiderstand aus. Dadurch wird der Betrieb bei hohen Gehäusetemperaturen und mit kleineren Kühlkörpern möglich.

Absolute Grenzwerte

Für Betrieb mit sinusförmigen Betriebsspannungen bei Frequenzen von 50/60 Hz an ohmscher oder induktiver Last

Periodische Spitzensperrspannung ¹	V_{DROM}	
Bei offenem Gate, $T_J = -40$ bis $+100^\circ\text{C}$	450 V
Effektivwert des Durchlaßstromes	$I_T(\text{RMSI})$	
Bei $T_C = 80^\circ\text{C}$ und Stromflußwinkel 360°	6 A
Stoßstrom (nichtperiodisch)	I_{TSM}	
Für eine Vollwelle der angelegten Hauptspannung		
60 Hz (sinusförmig)	100 A
50 Hz (sinusförmig)	85 A
Für mehr als eine Vollwelle der angelegten		
Hauptspannung	siehe Bild 4
Gate-Trigger-Spitzenstrom ²	I_{GTM}	
Für max. 10 μs	4 A
Gate Verlustleistung	P_{GM}	
Spitzenwert ² (max. 10 μs , $I_{GTM} \leq 4$ A (Spitzenwert))	16 W
Mittelwert	$P_G(\text{AV})$	0,2 W
Temperaturbereich ³		
Lagerung	T_{stg}	-40 bis $+150^\circ\text{C}$
Betrieb (Gehäuse)	T_C	-40 bis $+100^\circ\text{C}$

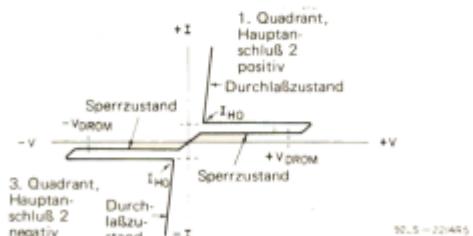


Bild 1 – Hauptstrom-Hauptspannungs-Kennlinie

1 Unabhängig von der Polarität der Spannung V_{MT2} an Hauptanschluß 2 in bezug auf Hauptanschluß 1

2 Unabhängig von der Polarität der Spannung V_G in bezug auf Hauptanschluß 1

3 Meßpunkt zur Messung der Gehäusetemperatur siehe Maßskizze

T2801DF

Blatt Nr. 493

Elektrische Kennwerte

bei absoluten Grenzwerten und angegebener Gehäusetemperatur, wenn nicht anders angegeben.

Kenngröße	Symbol	Grenzwerte			Einheit
		Min.	Typ.	Max.	
Spitzensperrstrom ¹ : Bei offenem Gate, V_{DROM} = max. Wert, $T_J = +100^\circ\text{C}$	I_{DROM}	—	0,1	2	mA
Maximale Durchlaßspannung ¹ : $i_T = 10 \text{ A}$ (Spitzenwert), $T_C = +25^\circ\text{C}$	V_{TM}	—	1,5	2,25	V
Kritische Steilheit der Kommutierungs spannung ^{1,3} : $V_D = V_{DROM}$, $I_T(\text{RMS}) = 6 \text{ A}$, Kommutier-di/dt = 3,2 A/ms, Gate nicht angesteuert $T_C = +80^\circ\text{C}$	dv/dt	2	10	—	V/ μ s
Kritische Spannungssteilheit ¹ : $V_D = V_{DROM}$, exponentieller Anstieg und offenes Gate $T_C = +100^\circ\text{C}$ Für andere Gehäusetemperaturen	dv/dt	20	250	—	V/ μ s
Siehe Bild 6					
Gate-Triggerstrom ² : $V_D = 12 \text{ V}$ (Gleichspannung), $R_L = 12 \Omega$ $T_C = 25^\circ\text{C}$, Zündbereich: I ⁺ -Bereich (VMT2 positiv, V_G positiv) III [−] -Bereich (VMT2 negativ, V_G negativ)	I_{GT}	—	25	80	mA
—	—	—	30	80	
Gate-Triggerspannung ^{1,2} : $V_D = 12 \text{ V}$ (Gleichspannung), $R_L = 12 \Omega$ $T_C = +25^\circ\text{C}$ Für andere Gehäusetemperaturen	V_{GT}	—	1,5	4,0	V
$V_D = V_{DROM}$, $R_L = 125 \Omega$ $T_C = +100^\circ\text{C}$		0,2	—	—	
Siehe Bild 10					
Einschaltzeit (Verzögerungszeit + Anstiegszeit): $V_D = V_{DROM}$, $I_{GT} = 80 \text{ mA}$, Anstiegszeit = 0,1 μ s, $i_T = 10 \text{ A}$ (Spitzenwert) $T_C = +25^\circ\text{C}$	t_{gt}	—	2,2	—	μ s
Wärmewiderstand:					
Zwischen Sperrsicht und Gehäuse	θ_{J-C}	—	—	2,2	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Zwischen Sperrsicht und Umgebung	θ_{J-A}	—	—	60	$^\circ\text{C}/\text{W}$

¹ Unabhängig von der Polarität der Spannung VMT2 an Hauptanschluß 2 in bezug auf Hauptanschluß 1² Unabhängig von der Polarität der Spannung V_G in bezug auf Hauptanschluß 1³ Varianten dieses Typs, bei denen die dv/dt-Eigenschaften speziell im Hinblick auf induktive Last selektiert sind, stehen auf Anfrage zur Verfügung

Blatt Nr. 493 -

T2801DF

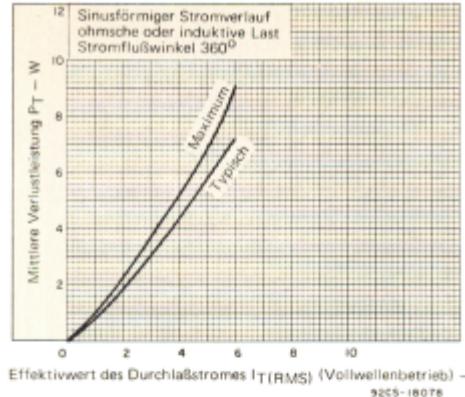


Bild 2 – Verlustleistung in Abhängigkeit vom Durchlaßstrom

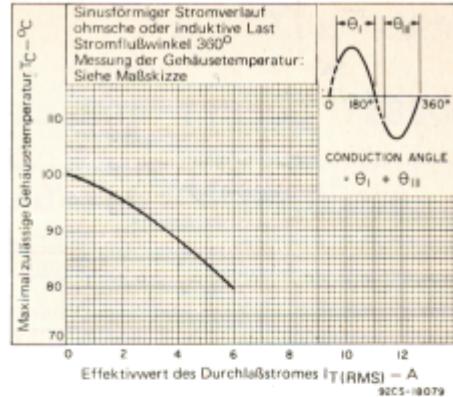


Bild 3 – Maximal zulässige Gehäusetemperatur in Abhängigkeit vom Durchlaßstrom

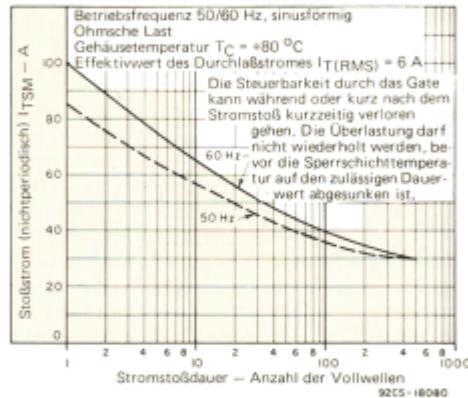


Bild 4 – Zulässiger Stoßstrom in Abhängigkeit von der Stromstoßdauer

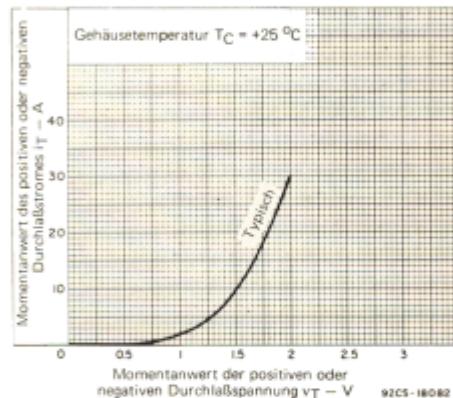


Bild 5 – Durchlaßstrom in Abhängigkeit von der Durchlaßspannung

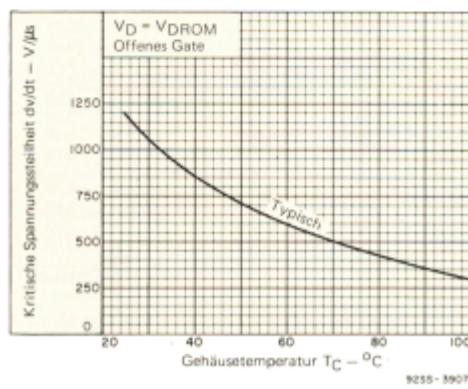


Bild 6 – Kritische Spannungssteilheit in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

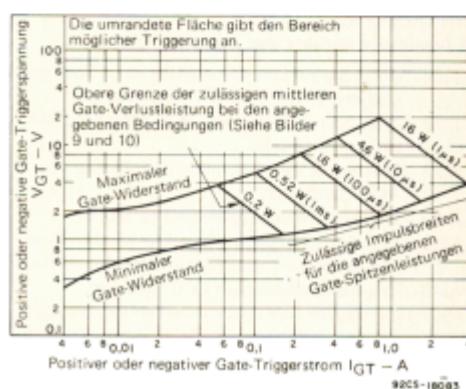
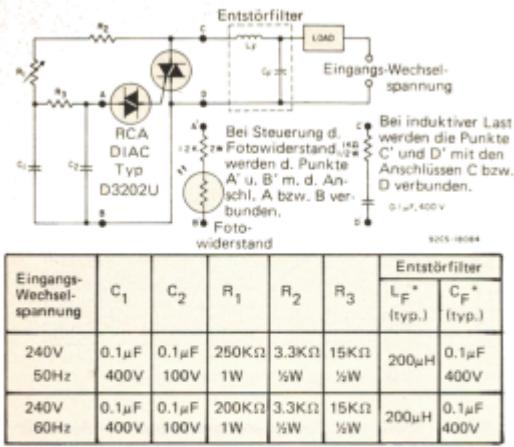


Bild 7 – Gate-Kennlinien für alle Triggerarten

T2801DF

Blatt Nr. 493



*Typische Werte für Lampen-Helligkeitssteuerungen

Bild 8 – Typische Phasenanschnittssteuerung für Lampen-Helligkeitsregler, Temperaturregelungen und Drehzahlsteuerungen für Universalmotoren

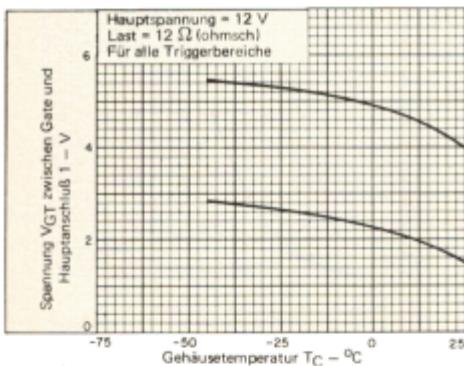


Bild 10 – Gate-Triggerspannung in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

RCA-Applikationsberichte über Triacs

- AN-3551 Anleitung zur Dimensionierung von einigen grundlegenden Thyristor- und Triacschaltungen
- AN-3778 Triac-Grundschaltungen zur Lichtregelung und ihre Wirkungsweise
- AN-3822 Thermische Gesichtspunkte beim Einbau von RCA-Thyristoren
- AN-3886 Wechselspannungsregler mit Thyristoren
- AN-4242 Ein Überblick über die charakteristischen Daten von Thyristoren und Triacs und ihre Anwendungen
- AN-4316 Triacschaltungen für Glühlampen
- AN-4537 Der Einsatz von Triacs in Verkehrssignalanlagen
- AN-4745 Das Dimensionieren von RC-Gliedern zur dv/dt-Unterdrückung in Triacschaltungen
- ST-2984 Dimensionierungsgesichtspunkte für Thyristor-Trigger-Kreise
- ST-4479 Thyristor for Power switching Applications

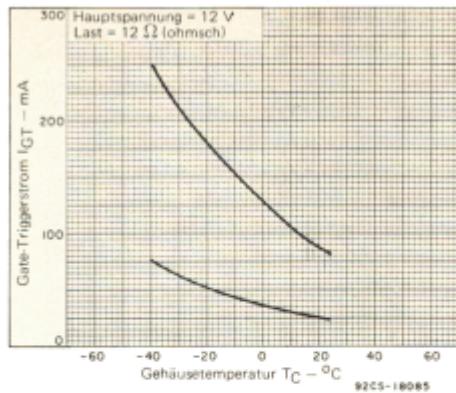
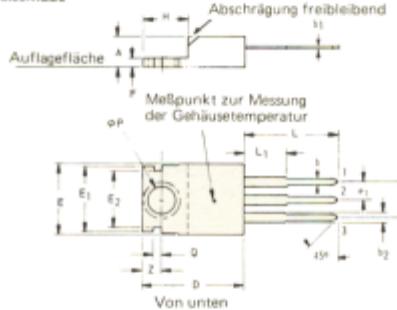


Bild 9 – Gate-Triggerstrom (für die Triggerbereiche I+ und III-) in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

Maßskizze



Symbol	Zoll		Millimeter	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0,160	0,190	4,07	4,82
b	0,025	0,040	0,64	1,02
b ₁	0,012	0,020	0,31	0,51
b ₂	0,045	0,055	1,143	1,397
D	0,575	0,600	14,61	15,24
E	0,395	0,410	10,04	10,41
E ₁	0,365	0,385	9,28	9,77
E ₂	0,300	0,320	7,62	8,12
e	0,180	0,220	4,57	5,58
e ₁	0,080	0,120	2,03	3,04
F	0,020	0,055	0,51	1,39
H	0,235	0,265	5,97	6,73
L	0,500	—	12,70	—
L ₁	—	0,250	—	6,35
φ _P	0,141	0,145	3,582	3,683
Q	0,040	0,060	1,02	1,52
Z	0,100	0,120	2,54	3,04

92CS-19700R1

Im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen von Thyristoren, die Schaltungstechnik und Anwendungsbeispiele von Triacs siehe „RCA-Halbleiterschaltungen der Leistungselektronik“, SP-51, Schutzgebühr.

Beim Einsatz von RCA-Halbleiter-Bauelementen sollten die „Operating Considerations for RCA Solid State Devices“, Form No. 1CE-402, berücksichtigt werden.